



Рис. 1. Зависимость средней величины плотности тока утечки затвора транзистора ($\langle J_3 \rangle$) от дозы ИИ азота (D_{N^+}) при обратном (B) и прямом (F) порядке термообработки для образцов, имплантированных N^+ , и для контрольных образцов (W/O). Энергия имплантации для доз $1 \cdot 10^{13}$; $5 \cdot 10^{13}$; $5 \cdot 10^{14}$ cm^{-2} – 20 кэВ, для дозы $2 \cdot 10^{13}$ cm^{-2} – 40 кэВ

Fig. 1. Dependence of the average leakage current density of the transistor gate ($\langle J_3 \rangle$) on the dose of nitrogen ion implantation (D_{N^+}) for the reverse (B) and forward (F) heat treatment samples implanted by N^+ and control samples (W/O). Implantation energy for doses of $1 \cdot 10^{13}$; $5 \cdot 10^{13}$; $5 \cdot 10^{14}$ cm^{-2} – 20 keV, for a dose of $2 \cdot 10^{13}$ cm^{-2} – 40 keV